® 日本 閩 特 許 庁(J P)

⑩特許出關公開

母公開特許公報(A)

昭60-134495

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和60年(1985)7月17日

H 05 K 3/4

3/46

6679~5F 6679~5F

審査請求 未請求 発明の数 2 (全10頁)

❷発明の名称 電気回路素子の製造方法

砂特 顧 昭59-251474

❷出 顧 昭59(1984)11月28日

優先権主張 @1983年11月28日 @米国(US) @555662

砂発 明 者 クラレンス・エル・ウ アメリカ合衆国カリフオルニア州92075, ソラナ・ビー

オーレイス チ, ハイランド 1036

の出 腹 人 タム・セラミツクス・ アメリカ合衆国ニユーヨーク州14305, ナイアガラ・フオ

インコーポレーテツド・ールズ、ハイド・パーク・ブールヴアード(香地なし)

砂代 理 人 弁理士 湯茂 恭三 外5名

明細套の浄容(内容に変更なし)

1913

33

1. 〔発明の名称〕

電気回路素子の製造方法

2. 〔特許請求の範囲〕

- 1 シートにヴァイア穴を形成する方法において、
 - a) ポンチ手段を用いて、ジートに引または 複数の穴を形成する段階と、
 - b) 1または複数の穴の上にヴァイア充填用 細片を整合させる段階と、
 - c) 前記ポンチ手段を用いて、前記細片から 充填材を打抜き、前記充填材を前記1つま たは複数の穴に入れる段階とを包含するこ とを特象とするヴァイアの形成方法。
- 2. 前記充塡材をおおむね金級粉末と結合剤の 混合体で構成することを特徴とする特許額求の範 翻算1項に記載した方法。
- 5. 前記 a) 段階が第1ストロークでポンチ手段 を変位させる段階を備え、および前記 b) 段階が前 記第1ストロークより短かい無2ストロークでポ

ンチ手段を変位させる段階を備えることを特象と する特許請求の範囲第1項に記載した方法。

- 4. 無2ポンチストロークが前配総片に最接近 したシートのほぼ外面で停止するようにしたこと を特敵とする特許請求の範囲第3項に記収した方 法。
- 5. 前記飯 2 ポンチストロークを餌 1 方向に向けて行ない、ポンチ手段およびシートを第 2 方向に変位させ、次いで前配 a)。b) およびc) 段階を反復する段階を備え、前配餌 2 方向が前配類 1 方向とおおむね直角であることを特徴とする特許請求の範囲銀 1 項に配載した方法。
- 6. 前記 b) 段階が前記細片をポンチ手段に対し、 変位させる段階を備えることを特徴とする特許調 求の範囲第2項に記載した方法。
- 7. 前配細片が供給ローラおよび取上げローラ 上に巻取られ、且つ前記2つのローラ間で前配シート上に伸長し、細片の前配変位が前配取上げローラを回転させる政階を備えることを特徴とする 特許請求の駆出年も項に記載した方法。

Carrier Service of the Control

转费昭G0-134495(2)

8. 前配り段階がポンテ手段により、シートに対して、前配細片を変位させる段階を備えることを特徴とする特許請求の範囲第5項に記載した方法。

9. さらに、d)シート上に回路を印刷する段階と、およびe)シート、回路および前記充損部分を高级と暴露し回路および充填部分を回路が充填部分と接触する状態でシートに結合する象階とを備えることを特象とする特許請求の範囲第1項に記載した方法。

10. 回路および充塡部分が前記結合後、電気的 に接触する金旗粒子を含有することを特象とする 毎許請求の範囲無り項に記載した方法。

11. 創記シートが前記 a) , b) およびc) 段階中、不充金な硬化状態にあるセラミックで構成し、および前記高温度をセラミックの完全硬化に必要な時間保持することを特徴とする特許請求の範囲第9項に記載した方法。

12. 多列の前配シート上に、前配 a), b), c) および d) 段階を実行する段階とおよび前配 e) 段階

17. シートが金属製で、および前記充填部分が セラミンクであることを特徴とする特許別求の範 囲第 1 項に配載した方法。

18. 金級シートの両側に輝い補助セラミックシートを位置決めする段階と、前記セラミックシートおよび前記充填部分を資通する穴を打抜き、前記穴のどの部分でも金属シートから間隔を有するようにする段階と、および導体を前記穴を貫通して伸長するように位置決めずる段階とを備えることを特徴とする特許請求の範囲第17項に記載した方法。

19. 前記セラミックシート、前記充填部分および前記導体を加熱する段階を備えることを特徴とする特許謝水の範囲郷18項に記載した方法。

20. シートが環状体であつて、および前配穴を シートの中心を貞涵するように打抜くことを特慮 とする特許請求の範囲第1項に記載した方法。

b) 穴の上にヴァイア充填用細片を整合させ

前に、前記シートを横重ねる段階とを備えること を特徴とする特許請求の範囲無り項に記載した方法。

13. シートの表面上に、元填部分と伝熱状態に 発熱チップを設ける段階と、および前記元填部分 を介して、チップからシートの反対側まで伝熱す る段階とを備えることを特徴とする特許消求の範 細郷1項に記載した方法。

14. チップ上の端子および前記シートと関係する端子間の電気接点を接続する段階を備えることを特敵とする特許請求の範囲無13項に記載した方法。

15. シートが金海製で且つその穴にエナメル系 充填部分を有し、および前記 a) 股階を実行して、 前記穴の前配エナメル系充填部分に前記穴を形成 することを特徴とする特許請求の範囲銀 1 項に記 縦した方法。

16. 前記シートをおおむねセラミックで構成することを特敵とする特許請求の範囲第1項に記載した方法。

る段階と、

- c) 前記ポンチを使用して、前記細片から光 填材を打抜き、前記充填材を前記穴の中に 入れる段階とを備える方法によつて形成し た電気回路器子において、
- d) 前記シートの穴は打抜いて形成され、
- e) 前記穴を充塡し、両端を前記シートの両 倒部とほぼ平らに整合させた金属系ヴァイ ア充填材を備えることを特徴とする亀気回 路案子。

22. シートの少なくとも片面に施こし、前記ヴァイア充填材と接触する塩準性金輝インキを備えることを特象とする特許請求の範囲餌21項に記載した毎毎回路要子。

23. 加熱した状態にあることを特徴とする特許 請求の範囲第22項に配収した複気回路案子。

24.a) 加熱した状態の電気回路業子と、

b) 前配穴内の金属と伝熱関係にあり、よつ て、前記チップの発生する熱を穴内の前記 充填材を介して熱伝達する前記シート上に

the second of the problem with the state of the second second second second second second second second second

設けたマイクロプロセツサチツブとを傭えることを特象とする特許請求の範囲第21 項に記載した電気回路素子。

25. 前記シートがインキ電極を互い違いの状態 に配散した平行な劇シートの横重ね体を備え、ポ ンチ手段をシートに対して位置決めする段階を備 え、前記の段階により、互い違いの電極に前配穴 を打抜くことを特徴とする特許請求の範囲第1項 に記載した方法。

26. シートに多列穴を打抜き、異なる電極に連続穴を貫通させる設階と、およびおおむね金融粉束と前配結合刺から取るヴァイアス充填材を前配穴内に打抜くことを特徴とする特許請求の範囲銀25項に配載した方法。

27. 前記シートを加熱して、競放物を形成する ことを特徴とする特許請求の範囲無26項に記載 した方法。

28. 前記ヴァイアス充填材を貫通する面で前記 シートを切断し、前記充填材を分割し、電導性板 を有するコンデンサを形成する段階を備え、各コ 特爾昭60~134495(3)

ンデンサの互い違いの板を分割した充填材で形成 した婚子に包気的に接続することを特徴とする特 許請求の範囲第27項に配載した方法。

29. シート上に電導体を形成し、前配異なる充 模材に接触させることを特徴とする特許請求の範 組第26項および第28項に配載した方法。

30. 前記シートが互い違いの状態に配散したインキ電極を有する平行な副シート装重ね体を備え、および前記ポンチを作動させて、円形配散の穴および中央穴を形成し、前記円形配散の穴内の充填材が前記互い違いの電極に接触しおよび中央穴内の充填材が中間電極に接触することを特徴とする特許病求の範囲第1項に配載した方法。

3. (発明の静細な説明)

本発明は全体として回路素子、棒に、焼成した セラミック多層基板およびパッケージのヴァイア (vias)の機械式充填方法に関する。

袋成させた多層セラミンク基板またはパンケー シはその内部または表面に電気回路を形成するセ ラミンク製構造体である。この多層構造体は業子

の製造中、各層に回路を配線する手段を提供する ものである。この回路を多層構造で配線する方法 は完成素子を小型化し得る点で、機準的な単一層 構造体と比べ値めて有利である。この基板はセラ ミック基材の材質と焼成するのに適した金属含有 ィンキを使用して、一枚ずつ電気回路をシルクス クリーン印刷したシートで製造される。各層の回 路を相互に連接し、また基根またはパツケージと 関係する外部回路に接続するための手段を設ける 必要がある。この接続方法は通常、国路印刷工程 前に、特別の工程として、金牌インキと数化金牌 インヰ、あるいはその何れか一方のインキを使用 して、充塡する適当な箇所でそのセラミツクシー トに打抜穴または穿孔を散ける段階が必要である。 この打抜穴または穿孔は業界用語でヴァイアス (vias)穴と称され、この穴に電導性インキを注 入することをヴァイア (via)充填という。 個々に 処理したセラミツクシート組立体は相互に正確に 正合させて、恢复に模立ね、そのセラミック・シ ートに使用した有機結合剤の程城如何によつて、

室温乃至250℃の温度で、基板面積1 cd当970 kg 乃至420 kg の圧力(1000~6000 &b√in²) で圧縮し、この圧縮工程により形成された多階構 遺体を次に、高温で加熱し、セラミックの競成と 金麗印刷部分の焼結を行ない、電導路を形成する。 暴傷金膜面の全面にめつきまたは保護金属膜を被 養すれば、多層標準体の製造が完了する。

ヴァイア充填の一般的な方法は従来のスクリーン目を通してインキを押出す方法である。 焼成される回路印刷に使用するのと向一の厚原インキを用いる。 予め打抜穴または望孔を設けたセラミック・シートを解除な真空チャック上に載せる。 セラミックシートのヴァイア穴と整合するスクリーンの小怪穴を通して、各ヴァイナス穴の上端に でガァイアス穴の近部に真空を作用させ、スクリーニング機械がヴァイアス穴の上端にインキを供着する 紫に、そのヴァイアス穴を通るインキの低下を促進させる働きをする。

上記充填方法には次のような多数の問題点があ

特閣昭60-134495 (4)

ል -

1. ヴァイアス穴に注入するインや量を正確に 脚節し得ない。大径穴の場合、穴の底部から作用 する吸引力によつて、過剰な量のインキが導入され、セラミンク・シートの底部までインキで汚れ てしまうことが多い。小径穴(直径 0.25 4 編以 下)の場合には、充填が不完全となる。

2 この充壌方法では、融長いヴァイアス穴、 即ち、長さ対ヴァイアス比がる:1以上のヴァイ アス穴を良好に充壌することができない。

3. ヴァイアス穴をインキで適切に充填した場合でさえ、インキ苑機様に、密剤の蒸発に起因する体績被少により、空隙が生じてしまう。

本発明の主たる目的は上述した問題点および離点を解析する方法およびその方法による製品を提供することである。

金属性インキおよびスクリーンを使用する方法 に代えて、打抜き方法を採用し、ヴァイア充塡用 材料シートの金属粉末スラグをグリーン (未硬化) 基板のヴァイア穴内に打抜く。

お得打抜きを必要とする。1ポンチ装置でヴァイアス穴の打抜きと光塡を行なうことができるので、正合上の間蜷は一切生じない。原版ごとにスクリーン工程を別にする必要もなく、また正合上の問題点等も解消し得る。

このヴァイア充壌方法はコンピュータ制御による連続的な打抜き工程に容易に適応することができる。この工程には、ヴァイア充壌材料(VFM)はリールに巻いた細片として用意し、軌道に沿つて送り、適当な位置に位置決めし、別の専用ポンチを使用してヴァイアス穴内に打抜く。

さらに、この方法は侵逃するように、エナメル 被援金獻基板、電導体を施工し、セラミックが金 擬基板内に充填される金殿基板上のセラミック被 後、マイクロプロセッサチップ用の支持板、伝熱 目的および多数多層セラミックコンデンサにも道 用することができる。

本発明の上記および他の目的、また利点並びに 実施関係例の詳細は以下の説明および森付図面か ちより一層理解し得るであろう。 1つのグリーンセラミック基板に一度に全ての ヴァイアス穴を打抜く、多列打抜き装置の場合、 基本的に次の3段階の工程を採用する。

- シート材を打抜き、ヴァイアス穴を形成し 得るようにポンチを調整する。
- 次化、限界ポンチ位置で基板化接触し得るようにポンチストロークを再調整する。
- 5. ヴァイアス穴光填用金属粉末でできたシート材を穴を打抜き、プレス内にあるセラミックシート上に戦せ、ポンチを作動させる。金属材料の厚みがセラミックシートの厚みと同一である場合には、1回のポンチストロークでヴァイア充填に必要な金属量を送入し、ヴァイアス穴を完全且つ正確に充填することができる。

インキの場合のように密剤が蒸発するようなことがないから、充填後のヴァイアス穴に空隙が生ずることはない。肉厚の薄い鍋造ヴァイア充填金屋を使用する場合、保さのある細長いヴァイアス穴については、ヴァイア充塡用金属シートの割出し

本明細書で使用する用船を次の通り定義づけする。

- A. 「インキ」ここで使用する場合、モリアデン、マンガン、タングステンまたは使用する 電導性セラミックとの適合性如何によつて供する他の金融のような微粉末金島を含有し、 スクリーン印刷に適した厚膜複質を意味する ものとする。
- B. 「セラミック・ウエア」上述した「インキ」を印刷する薄い可撓性材料をいう。この材料は必要な強度および取扱い上の特性を提供するプラスチック結合剤に感濁させた微細粉末セラミックで構成する。使用するセラミック材料は低電導率、優れた個度安定性、優れた機械的強度の如き超ましい電気的特性を示す多くの材料の1つである。
- C. 「焼成」セラミック・ウェアと金属インキの層でできた標准体に施し、講節速度下で加熱する方法をいう。 非金属および非セラミック材料は除々に「焼成」し、構造体が排出ガ

スによる感影響を受けないようにする。

先ず、第2図を参照すると、「グリーン」セラミックまたはウエアの海いシート10が示してある。次いで、この海いシートに1および一般には多数の小径穴を打抜く。この段階は11で示してある。この穴の直径は通常、数か00254頭である。第3図はアクチュエータ装置14によつて、矢印13の方向に向けて下方に動いたポンチ12を示す。

ポンス・ストロークはシートからおよびそのシートの穴、即ちヴァイアス穴16からセラミック 材料スラグを変位させるのに十分な偃である。そ の様、ポンチを後退させる。

次に、ポンチを後退位量にして、1または複数のヴァイアス穴上にヴァイアス穴充填細片 18を正合させる。次いで、第4回に示すように、ポンチを使用し、即ち下方に駆動して、充填細片 18から充填スラグを打抜き。そのスラグを穴 16内に入れる。細片 18の厚みはセラミンク釋シート10の厚みと同一またはこれに近い。次に、銀5

て、ポンチストローク間でこれら要素を移動させ (セラミックシート10に)ヴァイアス穴を多数 打抜き、また充填細片18から打抜いた充填スラ グ19でそのヴァイアス穴の充填を行なうことが できる。上記充填細片18はセラミック・シート 10と正合状態で走行するように、供給ロール28 から供給し、取り上げロール29で取り上げるこ とができる。充填スラグ19を充填した多別ヴァイアス穴は第9図に図示してあり、充填細片18 に 散けた穴は18 aで示してある。セラミック・シート10のホルグは30で示してある。

通常、次に、セラミック・シートの表面と裏面、もしくは片面に印刷回路を印刷する。かかる印刷回路は上記定義によるインキの増40で示してある。第2図の段階41を参照のこと。この層はヴァイアス穴充填材の上端と接触することができる。上記セラミック・シートを多列形成した後、このセラミック・シートは通常、第1図の段階42に示すように正確に整合した状態で積重ねられ、従って、インキ回路は所定のヴァイアス穴充填材に

特開昭60-134495(6)

図に示すように、ポンチ・ストロークを調整し、 スラクが正確にヴァイアス穴16に充填されるよ うにする。

単なる一例に過ぎないが、銀1センサ20はセラミックシート10からスラグ15が打抜かれると、ポンチに設けた銀1機能21が下端位置(銀3図参照)に到着したことを感知し、アクチュエータ14を超動してポンチ・ストロークを制動し、将度、ポンチを上方に後退させることができる。 銀2センサ22は無5図に示すように、銀1機能 21がセラミック・シート10にスラグ19を充填する該当中間位置に達したことを感知することができる。次に、アクチュエータ14はポンチの下方ストロークを制動し、舞3図に示すように、数ストローク・ポンチを上方に後退させる。

接触する。例えば、第1図参照のこと。次いで、 105万至420kg/cd(1500~6000psi)の 圧力で、横重ねたセラミック・シートの部分43 を圧縮する。その後、その横直ね体を加熱し、上 に定義した第2図の段階44の「斃成」を行なう。 様後に、第1図で金属階46および47で示した ように、積重ね体の外面に金属めつきを施す。と の段階は第2図で段階45として示してある。

単なる一例にしか過ぎないが、次のような組成 のヴァイアス穴充塡材を使用することができる。

P5 1	RALL U
タングステン粉末	50~80
酢酸ビニル樹脂結合剤	50~20
例Ⅱ	度推比 6
モリブデン粉末)50~80
マンガン粉末 (注)モリブデン粉末:マンガン粉3	ř
能師ビニル樹脂紡会剤	50~20

上記組成分を通常、完全に混合し、成形して得 いセラミンクシートにする。シートの尽みは例え

ZA T

特別昭60-134495(6)

ば、0.1524乃至0.762 mをする。

第10図はヴァイアス穴51を形成する金麻基板50を示す。そして、エナメル系光填材をヴァイアス穴51内に充填52してある。ポンチ53を作動させて、光填部分52に穴54を打抜く。その後、第3図および第4図に示すように、穴54に金羅系充填材を光填する。

例Ⅲ(エナメル系充填材)

フエロー・コーポレイション(Ferro Corp) のエナメル・エルポナ (ELPOR)(電子陽極 ガラスエナメル)

酢酸ピニル樹脂結合剤 E1-2020 または EL-2010 が例である。

7 図および # 8 図は # 1 0 1 を有し、例えば 酸化アルミニウムで製造することのできるセラミ ック系シート 1 0 0 を示す。 # 1 0 1 の下では、 セラミックシート 1 0 0 に金属系グアイアス充塡 1 2 を随す。 セラミックシート 1 0 0 を加熱して、 充填部分 1 2 に固層し、熱伝導し得るようにする。 # 1 0 1 内に回路(マイクロブロセッサ)「チッ ブ」またはウェハ103を埋込み、樗曲接点104を散けて、テップ端部の端子105をセラミックシート100の回路端子106に接続する。作用について説明すると、テップの発生する熱はヴァイアス充填路102を介して、セラミックシート100の裏側に接触する吸熱体(金属体)106まで下方向に伝達される。

本発明はまた、多層コンデンサを迅速且つ簡易に製造する場合にも適用することができる。第12 図は複数の副シートまたは降201-205(これ以外の枚数でもよい)で構成した基本シート200を示す。この副シートは公知の適当なセラミック材またはウエブで製造し、図示するように横渡ねることができる。候重ねる前に、刷シート級インキ電極を設け、副シートの横重ね時に、軍をが互い違いに位置するようにする。副シート203上の電径202上の電径202aは副シート203上の電径203aと、電磁203aは副シート204上の電径203aと、電磁203aとでなつている点に注

目する必要がある。「y」方向に同けてシート上れ互い違いに散けた電極は整合している。即ち、電極202aは204aと、電極203aは205aとそれぞれ整合している。「z」方向と匿角の「x」方向には、劇シート202上の電極202aおよび劇シート203上の電極203aの如き間様の電極は間深「g」だけ間隔を確して配散して配散して配散している。電極202aの間隔は連続する2電極203aの最さに等しく、また、逆に電磁203aの間隔は電極202aの長さに等しい。これら電極はイー・アイ(E.I)、デュボン(Dupont)、セルンクス(Selrex)、クラダン・インコーポレイテンド(Cladan Inc..)等の製造する電等性「インキ」で概成することができる。

本発明の別の実施組織によると、ポンテ12は 劇シート200に対して、「x」方向に位置失め する。この為、劇シート打抜さ段階は別の電値を 通つて、穴の打抜きを行うことができる。例えば 卸13回でポンチ12が別の電磁202aおよび 204aを適つて、欠107を打抜いているが、別の電極203aおよび205a間の間級106を通つていることを参照してみるとよい。また、例えば都13図で、同じポンチ12または別のポンチが別の電値、即ち電値203aおよび205aを通つて、次の連続穴109は電値203aを参照してみるとよい。次の連続穴109は電値203aが示してあり、その次の穴110は電値203aおよび205aを通いる。即ち、同一電値を交互に打抜いてあるのである。

前と同様、例えば結合剤御脂にバラジウム粒子を含有させた電導性の光媒材料を用いて、欠またはヴァイアス穴の光填を行なう。他の例としては、結合剤測脂に健または概とバラジウムの粒子を含有させたものがある。同一のポンチを使用して、上述したように、光填シートからの光填材209をヴァイアス穴内に充填することができる。各ヴァイアス穴内に充填することができる。

特開昭60-134495(ア)

次に、充填した側シート200を加熱して、樹脂筋成物を形成し、金属電低および端子または終端209を製造する。最後に、終端209を通るに従つてシートを切断し、この側シートを分割体209 a'と209b'に分ける。 その結果、電導板202a'と204a'を端子209b'にまた電導板203a'と205a'を端子209b'にそれぞれ接続したコンデンサが製造される。 第14 図に示した「z」方向に動いて、終端209'を分割体209b'に切断するカッタ刃210を参照するとよい。

その結果、得られたコンデンサ棒111が無15 図に示してある。打抜き穴、即ちヴァイアス穴の ェーリ面の断面形状は長方形とすることができる 点に注目すること。このコンデンサ棒111はェ ーェ面で切断して、(カンタがコンデンサ棒化交 叉する破線112を参照)小型のコンデンサを製 造することができる。図示したように増子には線 113および114を接続することができる。

第16図で、 囃子 209 a'の 端部を コンデンサ 標 1110 上に 被覆した 継導性イン 中 層 115 で接 続した状態が図示じてある。

必要ならば、端子には緩めつきし、即ち薄い鍼 インキを被優し、加熱して饒成することができる。 第17図乃至無23図に示した工程順序におい て、無17図は例えば鍋またはインパールで製造 した金属シート300の断面を示したものである。 卸18図は打抜き段階を示したもので、ポンチ 301を駆動して金属シートを打抜き、ヴァイア ス穴を形成する。スクラップは303で示してあ る。次いで、ポンチを後退させる。銀19図では、 電導性材料(未硬化の)から成る博厚の充填細片・ を金嶌シート300上に載せ、ヴァイアス穴302 の上に伸長させる。第20図では、ポンチ301 を下降させ、セラミック充填材305をヴァイア ス穴302内に打抜き、これを充塡する。次に、 金属シート300の両側に予備成形した奪い(廖 みが例えば 0.0 7 6 2 乃至 0.1 2 7 mm) セラミッ クシート306および307を聞いて、これを被 嫌し、またヴアイアス穴305を包い、その両端 と接触させる。第22図で、ヴァィアス穴305

の上には小型ポンチ308を心合せして位置決め し、小径(例えば、約0.1524歳)の貫通孔 309を完全に形成する。この貫通孔309の周 囲は図示したようにグリーンセラミツクヴアイア 材料で包囲し、グリーンセラミツク材料によつて 金庫シート300を貫通孔309から完全に絶縁 する。最後に穴る10内およびセラミック・シー トの両外側311と312に導体を設ける。この 導体は上述したインキで製造したもので、金幣層 の存在により堅牢な極薄の組立体を通つて伸長す る。次に、この組立体を加熱し、グリーンセラミ ツク部分305、306および301またインキ 導体310,311および312内で結合剤樹脂 を焼成させる。クリーンセラミツクは例えばフレ オン (Freon)中に相訳キシロール溶散を混合した 護形成型の結合剤樹脂中の蓄化ガラスまたはセラ ミックのような磁器材料で製造することができる。 その結果得られる饒成セラミックの膨張率は金属 基板300のそれと等しいか。またはほぼ祭しく なるようにし、温度変化により、セラミツクに塩

#24図および祭25図は第12図乃至銀14 図に示したのと同様の段階が示すものである。 差 本シート400はグリーンセラミンク材料または ウェブで製造し、互いに横重ねた(例えば)多重 膳401-406または側シートで標成する。 網 シートを検重ねた場合、例えば、402aおよび 403aで図示したように、互い違いに配散され るようにして、積重ね前、刷シートにインキ鉱値 を設ける。これら互い違いに配散した電域は擬方 同に整合している。

銀25図では、ポンチ412はストローク動作を行ない、互い違いの電極を縦方向に貫通する4つの穴を形成する。この穴は中間電低間の間膜も貫通する。穴408および409を参照。これらの穴は410で示すように、ヴァイア充壌材料で充壌される(ポンチを使用して)。充壌材料410

the second second

aは結合剤樹脂に復導性金属粉末を混合したものである。基本シート400の表面および底面にはインキ電低411を列状に、ヴァイア充填部分410の上端と接触するように印刷してある。この電極は打抜きおよび充填工程の前後を問わず形成することができる。次いで、第26図乃至額29図で413で示すように、刃412でシートを切断し、プロックを形成する。ヴァイア充填部分は第27図から明らかなように、半分割体410′に分割される。プロック1端にあるこの半分割体410′は互い違いの電値402a,404a,406aに接続し、プロックの反対側にある半分割体410′は中間電値403aおよび405aに接続する。

パス 4 1 1はプロツク 1 端の半分割体 410/と連接

し、また同様のバス 411 はプロック反対解婚部の

半分割体 410′と連接している。次に、プロツクを

加熱して、吸熱体およびヴァィア充填部分の有機

密剤または健質を焼成する。このようにして、コ

ンデンサを極めて容易に形成することができ、ま

た極小型コンデンサの製造も可能である。

第10回および第11回は変形シートの断面図、 第12回は電磁を互い違いに配設した多重層または副シートを有するセラミンクシートの断面図。

第13図はヴァイアス穴の打抜き、および充填 工程中および工程終了後の第12図に示したシートの断面図。

第14回は切断した場合の第12回のシート断 面図。

第15図はコンデンサの斜視図、

類 1 6 図は変形例を示す解 1 5 図と同様の斜視 図、

第17図乃至第23図はコンデンサ製造の段階 的処理を示す金属基板の断面図、

第24図および第25図は多列小型コンデンサ 製造の段階的処理を示す多重層セラミツクシート の断面図。

無26図は無24図および第25図の斜視図、 #27図乃至第29図は無26図に示したコン デンサのそれぞれ平面図、側面図、端面図、

銀30図は餌26図のコンデンサに類似した壊

特開昭60-134495(8)

都30図には、ヴァイア充填した半分割体510 および511を開降を置いて、セラミックシート 横重ね体501の内面および外面の周囲に配散し、 同一方法で形成した 環状コンデンサ500 および 環状パス(電導性インギ)512 および513が 示してある。ポンチ514を使用して、中央穴 515を形成する充塡部分の打抜き段階を示す第 31図および第32図も参照のこと。

4. 〔図面の簡単な説明〕

新1図は本発明に従って製造した製品の断面図、 第2図は工程図、

解3 図乃至無5 図は本発明に従つて加工したゥ エアの断面図。

無6図は印刷回路を印刷した後の無5図と同機 の断面図、

第7図は端子コネクタと共化セラミックウェア 基板上化散けたチップの平面図、

#8 図は # 7 図の #8 - 8 に 関する拡大断面図。 #8 9 図は本発明を具体化した相対的に可動要素 の単複図。

状コンデンサの斜視図、および

解31図および解32図は無30図の増长コン デンサの製造段階を示す断面図である。

10……グリーンセラミックシート

 14……アクテユエータ
 16……ヴァィアス穴

 18……ヴァィア充填細片
 19……死 塡 ス ラ グ

 20……郷 1 セ ン サ
 22……郷 2 セ ン サ

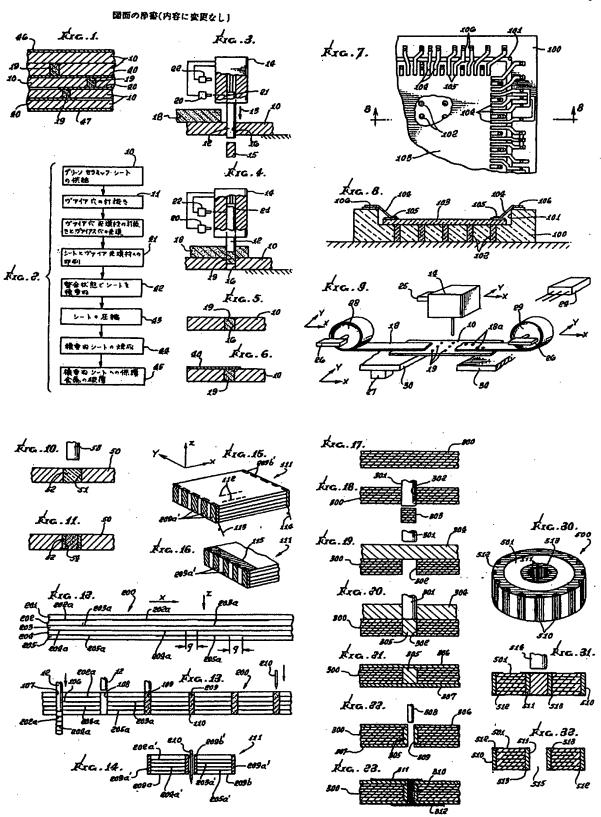
 24……銀 制 御 装 億
 21……線

 25-27…子制御装置
 40……ィ ン キ 盾

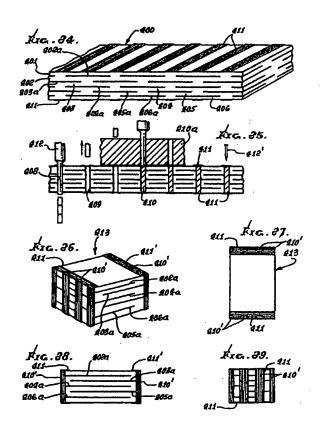
 50……基
 板

5 4 ……穴

代理人 弁理士 汤 线 恭 三层版 (外5名)



持開昭60-134495 (10)



手 続 補 正 智

昭和 60年 / 月3/日

特許厅 長官 志 賀

学 股

1.事件の表示。

昭和 59 年特許顧第 251474 号

2.発明の名称

電気回路素子の製造方法 **

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

住 所

名祭はタム・セラミックス・インコーポレーテット

4.代 理 人

在 所 東京都千代田区大手町二丁目 2番1号 新大手町に206号室(電話 270-6641-6) 氏 名 (2770) 弁理士 海 投 恭 三日報

5. 補正の対象

タイプした明和賞



6. 補正の内容

別紙の通り(なお、おま面とも内容には変更なし)